

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第4063225号
(P4063225)

(45) 発行日 平成20年3月19日 (2008.3.19)

(24) 登録日 平成20年1月11日 (2008.1.11)

(51) Int. Cl.

F I

G O 2 F 1/1333 (2006.01)

G O 2 F 1/1333 5 0 0

G O 2 F 1/1335 (2006.01)

G O 2 F 1/1335 5 1 0

請求項の数 4 (全 19 頁)

(21) 出願番号	特願2004-12612 (P2004-12612)	(73) 特許権者	000002185
(22) 出願日	平成16年1月21日 (2004.1.21)		ソニー株式会社
(65) 公開番号	特開2005-208185 (P2005-208185A)		東京都港区港南1丁目7番1号
(43) 公開日	平成17年8月4日 (2005.8.4)	(74) 代理人	100086298
審査請求日	平成17年3月8日 (2005.3.8)		弁理士 船橋 國則
前置審査		(72) 発明者	木下 智豊
			東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ
			ニー株式会社内
		(72) 発明者	浅野 明彦
			東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ
			ニー株式会社内
		審査官	右田 昌士
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

対向する1対の基板の少なくとも一方に液晶駆動用電極が形成され、
 前記基板間に設けたスペーサーにより前記基板間の間隔を保って形成された空間に液晶が封止された液晶表示装置において、
 前記一対の基板の少なくとも一方の基板がガラス繊維で形成されている繊維布を含有している樹脂基板であり、
 前記一対の基板の少なくとも一方の外側に偏光板が備えられ、
 前記繊維の軸と前記偏光板の光軸とが同軸であり、
 前記樹脂基板の繊維布が格子状の平織りの構造を成し、
 前記樹脂基板の主面内において、前記樹脂基板の厚み方向にみて、前記樹脂基板を構成する樹脂のみが存在する領域と、前記樹脂と前記繊維布とが存在する領域とを有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】

前記液晶駆動用の電極は、製造基板上に形成された後、繊維布を含有している樹脂基板に移載されたものからなる

ことを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項 3】

対向する1対の基板の少なくとも一方に液晶駆動用電極が形成され、

前記基板間に設けたスペーサーにより前記基板間の間隔を保って形成された空間に液晶

が封止された液晶表示装置の製造方法において、

前記一对の基板の少なくとも一方の基板にガラス繊維で形成されている繊維布を含有している樹脂基板を用い、

前記一对の基板の少なくとも一方の外側に偏光板を配設し、

前記繊維の軸と前記偏光板の光軸とを同軸とし、

前記樹脂基板の繊維布は、格子状の平織りの構造を成すものを用い、

前記樹脂基板の主面内において、前記樹脂基板の厚み方向にみて、前記樹脂基板を構成する樹脂のみが存在する領域と、前記樹脂と前記繊維布とが存在する領域とを有する

ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 4】

10

前記液晶駆動用の電極は、製造基板上に形成した後に繊維布を含有している樹脂基板に移載する

ことを特徴とする請求項 3 記載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、樹脂基板を用いる液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に関するものである。

【背景技術】

【0002】

20

近年、薄膜デバイスは、使用機器の小型化の影響を受けて、薄型化、軽量化、堅牢化に対する要求を受けている。しかしながら、液晶表示デバイスに使われる薄膜デバイスは、高温、真空という環境で作製されるために、製造に使われる基板に制限がある。例えば、薄膜トランジスタを用いた液晶表示装置では、1000 の温度に耐える石英基板、500 の温度に耐えるガラス基板が使われている。これらの基板の薄型化も検討されているが、石英基板、ガラス基板を用いる限り、基板の剛性が低下することを考慮して基板サイズを縮小せざるを得ず、それによって生産性が低下する。また、基板が薄くなれば堅牢さも急激に低下するため、実用上の問題点となる。

【0003】

このように、製造基板に要求されている性能と実際に使用する際に求められている性能とが異なる。また、薄型、軽量、堅牢化が可能なプラスチック基板上に直接、薄膜トランジスタを作製しようという試みもある。この場合、アクティブ素子を用いないパッシブ方式の液晶表示装置は、モノクロ型で量産化されているが、薄膜トランジスタや薄膜ダイオードを使用するアクティブ方式の液晶表示装置は、基板の耐熱温度の点から困難さが高い。

30

【0004】

そこで、耐熱温度の高い製造基板上に形成した薄膜デバイスを実使用基板に転写する技術が検討されている。転写する方法としては、剥離層を設けてデバイス作製後に剥離層から剥離する方法（例えば、特許文献 1 参照。）や、エッチングによりガラス基板を除去してしまう方法（例えば、特許文献 2 参照。）などが検討されている。これらの方法を使用

40

【0005】

しかしながら、膨張係数の高い通常のプラスチック基板に薄膜デバイス層を形成すると、主に無機層で形成されている薄膜デバイス層とプラスチック基板の膨張係数が違うため、形成後に加熱すると、反るといふ問題がある。また、反った状態でさらに温度を上げると、薄膜層にクラックが入って破壊することもある。そのため、薄膜デバイス層をプラスチック基板上に形成するためには、膨張係数の低いプラスチック基板を使用しなければならない。

【0006】

しかしながら、膨張係数の低いプラスチック基板は、非常に高価であったり、ポリイミ

50

ドのように着色されているものがあり、透過型の液晶表示装置に使用できないという問題がある。

【0007】

図14(a)の平面レイアウト図および図14(b)の斜視図に示すように、膨張係数の低いプラスチック基板501中に繊維布502を含有したものが知られている(例えば、特許文献3、4参照)。繊維布502としてはガラスクロスやポリイミドクロス、金属クロスなどが用いられていて、その中でもガラスクロスが最も多く用いられている。ガラスクロスと透明な樹脂を用いた場合、透明なプラスチック基板を作製することができ、そのプラスチック基板は透過型の液晶表示装置にも使用できる。ガラスクロスを含むプラスチック基板501は、液体状の樹脂にガラスクロスを含むさせ、加熱、光照射または溶剤を揮発させることによって、樹脂を硬化させて作製する。ガラスクロスとしては、縦横の線膨張係数を同じにするため、また強度が強くコストが安いことから、一般的には図14(a)に示すように格子状の平織りが用いられる。この場合、糸(繊維束)503と隣接する糸(繊維束)503との間には、樹脂が存在しており、樹脂のみの部分と繊維布502が入っている部分とが存在することになる。このようにして作製されたプラスチック基板501の線膨張係数は、面内方向で15ppm/K以下とすることが可能である。

10

【0008】

【特許文献1】特開平10-125930号公報

【特許文献2】特開2003-68995号公報

【特許文献3】特開平11-2812号公報

【特許文献4】特開2003-202816号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

20

【0009】

解決しようとする問題点は、ガラス繊維を含むプラスチック基板を用いた場合、プラスチック基板を形成する樹脂が硬化する時に、図15に示すように、ガラス繊維の重なり部(図面の丸印の部分)において、樹脂に応力がかかり、その部分の樹脂が複屈折を持つという問題がある点である。例えば、ガラス繊維入りのプラスチック基板を使用した液晶表示装置の光透過の概略を図16~図17によって説明する。図16~図17では、ノーマリーホワイトモードで、TN液晶に電圧をかけ黒表示をしようとしている状態を示す。

30

【0010】

図16は、ガラス繊維入りのプラスチック基板の領域の中で、ガラス繊維の重なり部分でない領域の光透過状態を示している。この領域は、複屈折を持たないため、バックライトから出た光は、第1偏光板560で直線偏光に変化し、そのままアクティブ基板510、液晶層520、対向基板530と透過して第2偏光板570まで到達し、第2偏光板570により完全に遮断され光を通さない。

【0011】

図17は、ガラス繊維の重なり部分で、複屈折の光軸と偏光板の軸が同軸ではない場合の光透過状態を示している。この場合は、バックライトから出た光は、第1偏光板560で直線偏光に変化し、直線偏光が複屈折の持つアクティブ基板510、液晶層520、対向基板530で楕円偏光に変わるため、第1偏光板560から第2偏光板570まで光が透過する。これにより、ガラス繊維が重なる部分とそれ以外の部分で明るさが違うという問題が起きる。また、黒以外の階調においても、ガラス繊維が重なる部分とそれ以外の部分の明るさが違うという問題が起きる。そのため、液晶表示装置として正常な表示ができない。

40

【課題を解決するための手段】

【0012】

本発明の液晶表示装置は、対向する1対の基板の少なくとも一方に液晶駆動用電極が形

50

成され、前記基板間に設けたスペーサーにより前記基板間の間隔を保って形成された空間に液晶が封止された液晶表示装置において、前記一对の基板の少なくとも一方の基板がガラス繊維で形成されている繊維布を含有している樹脂基板であり、前記一对の基板の少なくとも一方の外側に偏光板が備えられ、前記繊維の軸と前記偏光板の光軸とが同軸であり、前記樹脂基板の繊維布は、格子状の平織りの構造を成すものを用い、前記樹脂基板の主面内において、前記樹脂基板の厚み方向にみて、前記樹脂基板を構成する樹脂のみが存在する領域と、前記樹脂と前記繊維布とが存在する領域とを有することを最も主要な特徴とする。

【0013】

本発明の液晶表示装置の製造方法は、対向する1対の基板の少なくとも一方に液晶駆動用電極が形成され、前記基板間に設けたスペーサーにより前記基板間の間隔を保って形成された空間に液晶が封止された液晶表示装置の製造方法において、前記一对の基板の少なくとも一方の基板にガラス繊維で形成されている繊維布を含有している樹脂基板を用い、前記一对の基板の少なくとも一方の外側に偏光板を配設し、前記繊維の軸と前記偏光板の光軸とを同軸とし、前記樹脂基板の繊維布は、格子状の平織りの構造を成すものを用い、前記樹脂基板の主面内において、前記樹脂基板の厚み方向にみて、前記樹脂基板を構成する樹脂のみが存在する領域と、前記樹脂と前記繊維布とが存在する領域とを有することを最も主要な特徴とする。

【発明の効果】

【0014】

本発明者は、ガラス繊維の重なり部分の解析を行った結果、プラスチック基板の樹脂部分にかかる応力が、ガラス繊維の方向に沿っていることを見出し、それに基づいて、複屈折の光軸は、必ずガラス繊維方向となることを見出した。この知見に基づいて、本発明は成されている。すなわち、本発明の液晶表示装置およびその製造方法では、一对の基板の少なくとも一方の基板に繊維布を含有している樹脂基板を用い、一对の基板の少なくとも一方の外側に偏光板を備え、繊維の軸と偏光板の光軸とが同軸であるため、複屈折の光軸と偏光板の軸を同軸にすることができるので、複屈折の影響を排除し、ガラス繊維の重なり部分で、それ以外の部分と同じ正常表示が可能になるという利点がある。そのため、安価なガラスクロス入りのプラスチック基板を使用することができ、液晶表示装置の製造コストが安くなる。なお、ここでいう同軸とは、偏光板の光軸と繊維の少なくとも一つの軸が平行であることを示している。

【発明を実施するための最良の形態】

【0015】

プラスチック基板中にガラス繊維を含む場合、そのガラス繊維の重なり部分において、プラスチック基板を構成する樹脂に応力がかかり、その部分の樹脂が持つ複屈折の影響を排除するという目的を、対向する1対の基板の少なくとも一方に液晶駆動用電極が形成され、その基板間に設けたスペーサーにより基板間の間隔を保って形成された空間に液晶が封止された液晶表示装置において、上記一对の基板の少なくとも一方の基板が繊維布を含有している樹脂基板であり、上記一对の基板の少なくとも一方の外側に偏光板が備えられ、上記繊維の軸と前記偏光板の光軸とが同軸とすることで、ガラス繊維の重なり部分で、それ以外の部分と同じような正常表示を実現した。

【0016】

次に、具体的に本発明の液晶表示装置およびその製造方法に係る実施の形態例を、図1の模式断面図および図2の概略構成図によって説明する。この図2では、ノーマリーホワイトモードで、TN液晶に電圧をかけ黒表示をしようとしている状態を示す。

【0017】

図1に示すように、対向する1対の基板、すなわち、アクティブ基板11と対向基板12とを対向して設けて、その少なくとも一方に液晶駆動用電極（図示せず）を形成し、その基板間に設けたスペーサー（図示せず）により基板間の間隔を保って形成された空間に液晶層13を封止した液晶表示装置1である。上記一对の基板のうち、少なくとも一方の

基板には繊維布を含有している樹脂基板を用いている。図面の構成では一例として、アクティブ基板 11 に繊維布 16 が含有されている。この繊維布 16 は、格子状の平織りの構造を成すもので、アクティブ基板 11 の主面内において、アクティブ基板 11 の厚み方向に見て、アクティブ基板 11 を構成する樹脂のみが存在する領域と、樹脂と繊維布 16 とが存在する領域とを有するものであり、例えば繊維布 16 としては、ガラスクロスやポリイミドクロス、金属クロスなどを用いる。より好ましくは、ガラスクロスを用いる。また、図示はしないが、上記対向基板 12 に繊維布が含有された樹脂基板を用いることもできる。さらに、上記一对の基板の少なくとも一方の外側には偏光板を備える。図面では、アクティブ基板 11 の外側に第 1 偏光板 14 を設け、対向基板 12 の外側に第 2 偏光板 15 を設け、しかも上記繊維の軸（言い換えれば、複屈折の光軸）と第 1 偏光板 14 の偏光軸とを同軸方向に配置する。

10

【0018】

上記液晶表示装置の光透過の概略を図 2 によって説明する。図 2 に示すように、複屈折の光軸と第 1 偏光板 14 の軸が同軸の場合、第 1 偏光板 14 を通過した直線偏光は、複屈折を持つアクティブ基板 11 においても楕円偏光には変わらず、直線偏光のまま通過する。そのため光は第 2 偏光板 15 を通過できず、液晶表示装置としては、前記図 15 によって説明したのと同様な表示動作となる。すなわち、ガラス繊維入りのプラスチック基板の領域中で、ガラス繊維の重なり部分でない領域は、複屈折を持たないため、バックライトから出た光は、第 1 偏光板 14 で直線偏光に変化し、そのまま第 2 偏光板 15 まで到達し、第 2 偏光板 15 により完全に遮断され光を通さない。黒以外の階調においても同様にガラス繊維の重なり部分と他の部分は、同じ表示動作が可能となり液晶表示装置として正常な表示が可能となる。

20

【実施例 1】

【0019】

本発明の液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に係る第 1 実施例を、図 3 ~ 図 8 によって説明する。本実施例では、プラスチック基板に透過型液晶用のアクティブ基板を作製した。

【0020】

まず、薄膜デバイス層の形成方法を図 3 によって説明する。図 3 に示すように、第 1 基板 101 上に、後に行うフッ酸によるエッチング時における第 1 基板 101 の保護層 102 を形成する。上記第 1 基板 101 には、例えば厚さ 0.4 mm ~ 1.1 mm 程度、例えば 0.7 mm 厚のガラス基板を用いる。このガラス基板のかわりに石英基板を用いてもよい。上記保護層 102 は、フッ酸に耐えられる材料を用いて形成するもので、例えばモリブデン (Mo) 層を用い、例えば 500 nm の厚さに形成した。今回、モリブデン層の膜厚を 500 nm としたが、フッ酸に耐えられるならば、厚さを適宜変更しても問題ない。このモリブデンの保護層 102 は、例えばスパッタリング法によって成膜することができる。その後、絶縁層 103 を形成する。この絶縁層 103 は、例えば酸化珪素 (SiO₂) 膜を 500 nm の厚さに成膜して形成する。この絶縁層 103 は、例えばプラズマ CVD 法によって成膜することができる。

30

【0021】

次に、一般的な低温ポリシリコン技術、例えば「2003 FPDテクノロジー大全」（電子ジャーナル 2003 年 3 月 25 日発行、p. 166 - 183 および p. 198 - 201）、「'99 最新液晶プロセス技術」（プレスジャーナル 1998 年発行、p. 53 - 59）、「フラットパネル・ディスプレイ 1999」（日経 BP 社、1998 年発行、p. 132 - 139）等に記載されているような低温ポリシリコンボトムゲート型薄膜トランジスタ（以下薄膜トランジスタを TFT と記す）プロセスで TFT を含む薄膜デバイス層を形成した。薄膜デバイス層の形成方法の一例を以下に説明する。

40

【0022】

まず、第 1 基板 101 上に保護層 102 を介して形成された絶縁層 103 上にゲート電極 104 を形成するための導電膜を形成した。この導電膜には例えば厚さが 100 nm の

50

モリブデン (Mo) 膜を用いた。モリブデン膜の形成方法としては例えばスパッタリング法を用いた。そして上記導電膜をゲート電極 104 に形成した。このゲート電極 104 は、一般的なフォトリソグラフィ技術およびエッチング技術によりパターンニングして形成した。次いで、ゲート電極 104 上を被覆するようにゲート絶縁膜 105 を形成した。ゲート絶縁膜 105 は、例えばプラズマ CVD 法によって、酸化珪素 (SiO_2) 層、または酸化珪素 (SiO_2) 層と窒化珪素 (SiN_x) 層との積層体で形成した。さらに連続的に非晶質シリコン層 (厚さ 30 nm ~ 100 nm) を形成した。

【0023】

この非晶質シリコン層に波長 308 nm の XeCl エキシマレーザパルス照射し熔融再結晶化し結晶シリコン層 (ポリシリコン層) を作製した。このポリシリコン層を用いて、チャンネル形成領域となるポリシリコン層 106 を形成し、その両側に n^- 型ドープ領域からなるポリシリコン層 107、 n^+ 型ドープ領域からなるポリシリコン層 108 を形成した。このように、アクティブ領域は高いオン電流と低いオフ電流を両立するための LDD (Lightly Doped Drain) 構造とした。またポリシリコン層 106 上には n^- 型のリンイオン打込み時にチャンネルを保護するためのストッパー層 109 を形成した。このストッパー層 109 は、例えば酸化珪素 (SiO_2) 層で形成した。

【0024】

さらに、プラズマ CVD 法によって、酸化珪素 (SiO_2) 層、または酸化珪素 (SiO_2) 層と窒化珪素 (SiN_x) 層との積層体からなるパッシベーション膜 110 を形成した。このパッシベーション膜 110 上に、各ポリシリコン層 108 に接続するソース電極 111 およびドレイン電極 112 を形成した。各ソース電極 111 およびドレイン電極 112 は例えばアルミニウム、アルミニウム合金、高融点金属等の導電性材料で形成した。

【0025】

各ソース電極 111 およびドレイン電極 112 形成した後、カラーフィルター 113 を形成した。カラーフィルター 113 は、カラーレジストを全面に塗布した後、リソグラフィ技術でパターンニングを行って形成した。カラーフィルター 113 には、ソース電極 111 と後に形成する液晶駆動用電極が接続されるようにコンタクトホール 113C を形成した。このカラーフィルターの形成工程を 3 回行って、RGB の 3 色 (赤、緑、青) を形成した。次に、平坦化を行うために保護膜 114 を形成した。保護膜 114 は例えばポリメチルメタクリル酸樹脂系の樹脂により形成した。また保護膜 114 には、ソース電極 111 と液晶駆動用電極とが接続されるようにコンタクトホール 114C を形成した。その後、ソース電極 111 に接続する画素電極 115 を形成した。この画素電極 115 は、例えば、透明電極で形成される。透明電極としては、例えばインジウムスズオキシド (ITO) により形成され、その形成方法としてはスパッタリング法が用いられる。

【0026】

以上の工程により、第 1 基板 101 上に透過型のアクティブマトリックス基板が作製できた。また、今回は、ボトムゲート型ポリシリコン TFT を作製したが、トップゲート型ポリシリコン TFT やアモルファス TFT でも同様に実施できる。

【0027】

次に、第 1 基板 101 上の薄膜デバイス層 121 をプラスチック基板上に移載する工程を説明する。

【0028】

図 4 (1) に示すように、第 1 基板 101 上に保護層 102、絶縁層 103、薄膜デバイス層 121 を形成したものをホットプレート 122 で 80 ~ 140 に加熱しながら、第 1 接着剤 123 を厚さ 1 mm 程度に塗布し、第 2 基板 124 を上に載せ、加圧しながら、室温まで冷却した。第 2 基板 124 には、例えば厚さ 1 mm のモリブデン基板を用いた。または、第 2 基板 124 にガラス基板を用いてもよい。または、第 2 基板 124 上に第 1 接着剤 123 を塗布して、その上に保護層 102 から薄膜デバイス層 121 が形成された第 1 基板 101 の薄膜デバイス層 121 側を載せてもよい。上記第 1 接着剤 123 には、例えばホットメルト接着剤を用いた。

10

20

30

40

50

【 0 0 2 9 】

次に、図 4 (2) に示すように、第 2 基板 1 2 4 を貼り付けた第 1 基板 1 0 1 をフッ酸 (H F) 1 2 5 に浸漬して、第 1 基板 1 0 1 のエッチングを行った。このエッチングは、保護層 1 0 2 である酸化アルミニウム層がフッ酸 1 2 5 にエッチングされないため、このエッチングは保護層 1 0 2 で自動的に停止する。ここで用いたフッ酸 1 2 5 は、一例として、重量濃度が 5 0 % のもので、このエッチング時間は 3 . 5 時間とした。フッ酸 1 2 5 の濃度とエッチング時間は、第 1 基板 1 0 1 のガラスを完全にエッチングすることができるならば、変更しても問題はない。

【 0 0 3 0 】

上記フッ化水素酸 1 2 5 によるエッチングの結果、図 5 (3) に示すように、第 1 基板 1 0 1 [前記図 4 (2) 参照] が完全にエッチングされ、保護層 1 0 2 が露出される。

10

【 0 0 3 1 】

次に、混酸 [例えば、リン酸 (H_3PO_4) 7 2 wt % と硝酸 (HNO_3) 3 wt % と酢酸 (CH_3COOH) 1 0 wt %] により、保護層 1 0 2 [前記図 5 (3) 参照] であるモリブデン層 (厚さ : 5 0 0 nm) をエッチングした。これは、透過型の液晶パネルを作製するために、不透明なモリブデン層があると問題となるためである。上記混酸で 5 0 0 nm の厚さのモリブデン層をエッチングするのに必要な時間は約 1 分である。このエッチングの結果、図 5 (4) に示すように、この混酸は第 1 絶縁層 1 0 3 である酸化珪素をエッチングしないため、第 1 絶縁層 1 0 3 で自動的にエッチングが停止する。

【 0 0 3 2 】

20

次に、図 5 (5) に示すように、上記エッチング後に、薄膜デバイス層 1 2 1 の裏面側、すなわち絶縁層 1 0 3 表面に、第 2 接着層 1 2 6 を形成した。第 2 接着層 1 2 6 には例えば紫外線硬化型接着剤を用いた。

【 0 0 3 3 】

続けて、上記第 2 接着層 1 2 6 に第 3 基板 1 2 7 を貼り付けた。第 3 基板 1 2 7 には繊維布 1 2 8 が含有されており、例えば第 3 基板 1 2 7 には、ガラスクロス入りプラスチック基板を用いた。上記プラスチック基板は、酸化ケイ素を主成分とするガラスクロスを含んだエポキシ樹脂で構成されている。ガラスクロスは以下のように形成される。例えば、直径 $1 \mu m \sim 20 \mu m$ 程度の細いガラス線を数本から数十本束ねて直径 $10 \mu m \sim 300 \mu m$ の一本の糸とする。今回は、直径約 $100 \mu m$ の糸を使用した。この糸を平織りにして形成される。平織りのため、縦糸と横糸とが直交している。これにより、基板の線膨張係数は、基板面内の縦方向と横方向とで等しくなる。今回使用した基板の線膨張係数は $13 ppm / K$ である。無機薄膜層との熱膨張率差を考えると $30 ppm$ 以下、望ましくは $15 ppm$ 以下がよい。基板の厚さは、 $10 \mu m \sim 500 \mu m$ が望ましく、今回は基板の厚さは $200 \mu m$ である。その後、紫外線を照射して第 2 接着層 1 2 6 を硬化させた。

30

【 0 0 3 4 】

次に、上記基板をアルコール (図示せず) 中に浸漬し、ホットメルト接着剤からなる第 1 接着層 1 2 3 [前記図 4 (1) 参照] を溶かして第 2 基板 1 2 4 [前記図 4 (1) 参照] を外した。その結果、図 6 (6) に示すように、繊維布 1 2 8 を含有する第 3 基板 1 2 7 上に第 2 接着層 1 2 6、絶縁層 1 0 3 を介して薄膜デバイス層 1 2 1 が載った薄膜デバイス (アクティブ基板) 1 0 0 を得た。

40

【 0 0 3 5 】

次に、対向基板の製造例を、図 7 の概略構成断面図によって説明する。

【 0 0 3 6 】

図 7 に示すように、対向基板 1 3 0 としては、プラスチック基板 1 3 1 を用意し、さらに上記プラスチック基板 1 3 1 側の全面に透明電極 1 3 2 を形成したものである。この透明電極 1 3 2 には、例えば I T O (インジウムスズオキシド) を用いた。この I T O 膜は、例えばスパッタ法により成膜した。

【 0 0 3 7 】

次に、図 8 に示すように、上記対向基板 1 3 0 とアクティブ基板 1 0 0 とに図示はしな

50

いが配向膜（例えばポリイミド膜）を塗布してラビング処理を行う配向処理を行った。ラビング方向は、アクティブ基板 100 に含有されているガラス繊維の一方向にラビングを行い、対向基板 130 とアクティブ基板 100 とで互いに直交するように行った。

【0038】

次に、アクティブ基板 100 にはシール剤（図示せず）を塗布し、対向基板 130 には多数のスペーサー（図示せず）を散布した。

【0039】

そして、アクティブ基板 100 と対向基板 130 とを張り合わせた後、例えば 1 kg/cm^2 で加圧しながら紫外線を照射してシール剤を硬化させた。次に、レーザー加工によりパネルの大きさに切断した後、注入口（図示せず）から液晶 150 を注入して、注入口をモールド樹脂で覆い、モールド樹脂を硬化させ、液晶表示パネルを作製した。今回は液晶には TN 液晶を用いた。

【0040】

上記液晶表示パネルの両側、すなわち、アクティブ基板 100 の外側に第 1 偏光板 160 を貼り付けるとともに、対向基板 130 の外側に第 2 偏光板 170 を貼り付けて、液晶表示装置とした。第 1、第 2 偏光板 160、170 は、前記図 2 によって説明したのと同様に、偏光軸が互い直交する（垂直になる）ように貼り合わせた。今回は、ノーマリーホワイトモードとしたが、ノーマリーブラックモードにするには、2 枚の偏光板を垂直にするまたはアクティブ基板と対向基板のラビングを並行にするなどの変更を行えばよい。なお、偏光板の軸とラビング方向を上記のようにクロス軸に合わせれば、クロス軸は、基板に対してどのような角度で入っていてもよく、その場合、視野角などが改善する場合もある。

【0041】

上記工程により作製した液晶表示装置は、基板の線膨張係数が低いため、温度を上げてもクラック等は発生しない。また、ガラスクロス入りプラスチック基板だが、ガラス繊維の繊維方向と偏光板の光軸が同じ方向であるため、繊維が重なった部分も重なっていない部分と同じ表示となる。

【0042】

本発明は、本発明者により見出されたガラス繊維の重なり部分の解析の結果、すなわち、プラスチック基板の樹脂部分にかかる応力が、ガラス繊維の方向に沿っていることを見出したことに基づいて、複屈折の光軸は、必ずガラス繊維方向となるということによる。この知見に基づいて、本発明は成されており、本発明の液晶表示装置およびその製造方法では、一对の基板の少なくとも一方の基板、第 1 実施例ではアクティブ基板 100 に繊維布 128 を含有している樹脂製の第 3 基板 127 を用い、アクティブ基板 100 および対向基板 130 のそれぞれの外側に第 1、第 2 偏光板 160、170 を備え、繊維の軸と偏光板の光軸とが同軸であるため、複屈折の光軸と第 1 偏光板 160 の軸を同軸にすることができるので、複屈折の影響を排除し、ガラス繊維の重なり部分で、それ以外の部分と同じ正常表示が可能になるという利点がある。そのため、安価なガラスクロス入りのプラスチック基板を使用することができ、液晶表示装置の製造コストが安くなる。

【実施例 2】

【0043】

本発明の液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に係る第 2 実施例を、図 9～図 11 の断面図によって説明する。第 2 実施例では、プラスチック基板上に反射型液晶用のアクティブ基板を作製した。

【0044】

まず、薄膜デバイス層の形成方法を図 9 によって説明する。図 9 に示すように、第 1 基板 201 上にアモルファスシリコン層 202 を形成する。上記第 1 基板 201 には、例えば厚さ $0.4\text{ mm} \sim 1.1\text{ mm}$ 程度、例えば 0.7 mm 厚のガラス基板を用いる。このガラス基板のかわりに石英基板を用いてもよい。また上記アモルファスシリコン層 202 の膜厚は、例えば 50 nm とした。この膜厚は $10\text{ nm} \sim 1\text{ }\mu\text{m}$ であるならば問題はない。

アモルファスシリコン層 202 の成膜方法は、プラズマ CVD 法を用いた。プラズマ CVD 法では、アモルファスシリコン層 202 中に、水素を多く含むように、また製造途中で薄膜デバイス層が剥がれない限りの低温が望ましい。今回は 150℃ にて成膜を行った。また、低圧 CVD 法、大気圧プラズマ CVD 法、ECR 法、スパッタ法によりアモルファスシリコン層 202 を成膜しても問題はない。

【0045】

次いで、上記アモルファスシリコン層 202 上に保護絶縁層 203 を成膜する。この保護絶縁層 203 は、例えば 100 nm の厚さに形成した。この保護絶縁層 203 は、例えばプラズマ CVD 法によって成膜することができる。

【0046】

その後、一般的な低温ポリシリコン技術、例えば「2003 FPD テクノロジー大全」(電子ジャーナル 2003 年 3 月 25 日発行、p. 166 - 183 および p. 198 - 201)、「'99 最新液晶プロセス技術」(プレスジャーナル 1998 年発行、p. 53 - 59)、「フラットパネル・ディスプレイ 1999」(日経 BP 社、1998 年発行、p. 132 - 139)等に記載されているような低温ポリシリコンボトムゲート型薄膜トランジスタ(以下薄膜トランジスタを TFT と記す)プロセスで TFT を含む薄膜デバイス層を形成した。薄膜デバイス層の形成方法の一例を以下に説明する。

【0047】

まず、第 1 基板 201 上にアモルファスシリコン層 202 を介して形成された保護絶縁層 203 上にゲート電極 204 を形成するための導電膜を形成した。この導電膜には例えば厚さが 100 nm のモリブデン (Mo) 膜を用いた。モリブデン膜の形成方法としては例えばスパッタリング法を用いた。そして上記導電膜をゲート電極 204 に形成した。このゲート電極 204 は、一般的なフォトリソグラフィ技術およびエッチング技術によりパターンニングして形成した。次いで、ゲート電極 204 上を被覆するようにゲート絶縁膜 205 を形成した。ゲート絶縁膜 205 は、例えばプラズマ CVD 法によって、酸化珪素 (SiO₂) 層、または酸化珪素 (SiO₂) 層と窒化珪素 (SiN_x) 層との積層体で形成した。さらに連続的に非晶質シリコン層(厚さ 30 nm ~ 100 nm)を形成した。

【0048】

この非晶質シリコン層に波長 308 nm の XeCl エキシマレーザパルス照射を照射し熔融再結晶化し結晶シリコン層(ポリシリコン層)を作製した。このポリシリコン層を用いて、チャンネル形成領域となるポリシリコン層 206 を形成し、その両側に n⁻型ドープ領域からなるポリシリコン層 207、n⁺型ドープ領域からなるポリシリコン層 208 を形成した。このように、アクティブ領域は高いオン電流と低いオフ電流を両立するための LDD (Lightly Doped Drain) 構造とした。またポリシリコン層 206 上には n⁻型のリンイオン打込み時にチャンネルを保護するためのストッパー層 209 を形成した。このストッパー層 209 は、例えば酸化珪素 (SiO₂) 層で形成した。

【0049】

さらに、プラズマ CVD 法によって、酸化珪素 (SiO₂) 層、または酸化珪素 (SiO₂) 層と窒化珪素 (SiN_x) 層との積層体からなるパッシベーション膜 210 を形成した。このパッシベーション膜 210 上に、各ポリシリコン層 208 に接続するソース電極 211 およびドレイン電極 212 を形成した。各ソース電極 211 およびドレイン電極 212 は例えばアルミニウム、アルミニウム合金、高融点金属等の導電性材料で形成した。

【0050】

ソース電極 211 およびドレイン電極 212 形成した後、素子を保護するためと平坦化を行うために保護層 213 を形成した。保護層 213 は、例えばポリメチルメタクリル樹脂系の材料で形成される。そして、保護層 213 は、次工程で保護層 213 上に形成される反射層表面に凹凸が形成されるように、上記保護層 213 表面が凹凸となるように形成される。次いで、通常のコンタクトホール形成技術によって、保護膜 213 に、ソース電極 211 と後に形成される液晶駆動用電極とが接続されるようにコンタクトホール 213C を形成した。その後、上記保護層 213 表面およびコンタクトホール 213C 内面に

10

20

30

40

50

、反射層 2 1 4 を形成した。この反射層 2 1 4 は、例えばスパッタリングによって銀 (A g) を堆積して形成した。

【 0 0 5 1 】

上記反射層 2 1 4 を形成後、カラーフィルター 2 1 5 を形成した。これは、カラーレジストを全面に塗布した後、リソグラフィ技術でパターンニングを行って形成した。次いで、カラーフィルター 2 1 5 に、ソース電極 2 1 1 と後に形成される液晶駆動用電極が接続されるようにコンタクトホール 2 1 5 C を形成した。このカラーフィルターの形成工程を 3 回行って、 R G B の 3 色 (赤、緑、青) を形成した。

【 0 0 5 2 】

その後、上記カラーフィルター 2 1 5 表面およびコンタクトホール 2 1 5 C 内面に画素電極 2 1 6 を形成した。この画素電極 2 1 6 は、例えばインジウムスズオキサイド (I T O) を、例えばスパッタリングによって堆積して形成した。したがって、画素電極 2 1 6 はソース電極 2 1 1 に接続して形成される。

【 0 0 5 3 】

以上の工程により、ガラス基板からなる第 1 基板 2 0 1 上にアクティブマトリックス基板が作製できた。また、今回は、ボトムゲート型ポリシリコン T F T を作製したが、トップゲート型ポリシリコン T F T やアモルファス T F T でも同じように実施できる。

【 0 0 5 4 】

次に、第 1 基板 2 0 1 上の薄膜デバイス層をプラスチック基板上に移載する工程を説明する。

【 0 0 5 5 】

図 1 0 (1) に示すように、第 1 基板 2 0 1 上にアモルファスシリコン層 2 0 2 、保護絶縁層 2 0 3 を介して形成されている薄膜デバイス層 2 2 1 に、第 1 接着剤 2 2 2 を介して第 2 基板 2 2 3 を貼り付ける。この第 2 基板 2 2 3 には、例えば厚さ 1 m m のモリブデン基板を用いた。または、第 2 基板 2 2 3 にガラス基板を用いてもよい。または、第 2 基板 2 2 3 上に第 1 接着剤 2 2 2 を形成して、その上にアモルファスシリコン層 2 0 2 から薄膜デバイス層 2 2 1 までが形成された第 1 基板 2 0 1 の薄膜デバイス層 2 2 1 側を載せてもよい。上記第 1 接着剤 2 2 2 には、例えばホットメルト接着剤を用いた。

【 0 0 5 6 】

次に、ガラス基板からなる第 1 基板 2 0 1 側からキセノン塩素 (X e C l) エキシマレーザー光を照射した。ガラスは上記エキシマレーザー光を透過させるため、レーザー光は、アモルファスシリコン層 2 0 2 で吸収される。アモルファスシリコン層 2 0 2 に紫外線が吸収されると水素が発生し、アモルファスシリコン層 2 0 2 を境として薄膜デバイス層 2 2 1 と第 1 基板 2 0 1 との分離が起きる。この技術の詳細は、特開平 1 0 - 1 2 5 9 3 0 号公報に開示されている。その結果、図 1 0 (2) に示すように、保護絶縁層 2 0 3 が露出された。

【 0 0 5 7 】

次に、図 1 0 (3) に示すように、保護絶縁層 2 0 3 に第 2 接着層 2 2 4 を形成した。この第 2 接着層 2 2 4 は、例えば紫外線硬化接着剤を塗布により形成される。塗布方法は、スプレーコーティング、ディップコーティングもしくはスピンコーティングを用いることができる。

【 0 0 5 8 】

続けて、上記第 2 接着層 2 2 4 に第 3 基板 2 2 5 を貼り付けた。この第 3 基板 2 2 5 には繊維布 2 2 6 が含有されており、例えば第 3 基板 2 2 5 には、ガラスクロス入りプラスチック基板を用いた。上記プラスチック基板は、酸化ケイ素を主成分とするガラスクロスを含んだエポキシ樹脂で構成されている。ガラスクロスは以下のように形成される。例えば、直径 1 μ m ~ 2 0 μ m 程度の細いガラス線を数本から数十本束ねて直径 1 0 μ m ~ 3 0 0 μ m の一本の糸とする。今回は、直径約 1 0 0 μ m の糸を使用した。この糸を平織りにして形成される。平織りのため、縦糸と横糸とが直交している。これにより、基板の線膨張係数は、基板面内の縦方向と横方向とで等しくなる。今回使用した基板の線膨張係数

10

20

30

40

50

は13ppm/Kである。無機薄膜層との熱膨張率差を考えると30ppm以下、望ましくは15ppm以下がよい。基板の厚さは、10 μ m~500 μ mが望ましく、今回は基板の厚さは200 μ mである。その後、紫外線を照射して第2接着層224を硬化させた。

【0059】

次に、上記基板をアルコール中に浸漬し、ホットメルト接着剤からなる第1接着層222を溶かして第2基板223を外した。その結果、薄膜デバイス層221が露出され、図11(4)に示すように、第3基板225上に第2接着層224、保護絶縁層203を介して薄膜デバイス層221が載った薄膜デバイス(アクティブ基板)200を得た。

【0060】

次に、図示はしないが、前記図8によって説明したのと同様にして、上記対向基板130とアクティブ基板200とに配向膜(例えばポリイミド膜)を塗布し、ラビング処理を行う配向処理を行った。ラビング方向は、アクティブ基板200に含有されているガラス繊維方向にラビングを行い、対向基板130とアクティブ基板200で互いに直交するように行った。

【0061】

次に、アクティブ基板200にはシール剤(図示せず)を塗布し、対向基板130には多数のスペーサーを散布した。

【0062】

そして、アクティブ基板200と対向基板130とを張り合わせた後、例えば1kg/cm²で加圧しながら紫外線を照射してシール剤を硬化させた。次に、レーザー加工によりパネルの大きさに切断した後、注入口から液晶150を注入して、注入口をモールド樹脂で覆い、モールド樹脂を硬化させ、液晶表示パネルを作製した。今回は液晶にはTN液晶を用いた。

【0063】

上記第2実施例では、前記第1実施例と同様に、一对の基板の少なくとも一方の基板、としてアクティブ基板200に繊維布226を含有している樹脂製の第3基板225を用い、アクティブ基板200および対向基板130のそれぞれの外側に第1、第2偏光板160、170を備え、繊維の軸と偏光板の光軸とが同軸であるため、複屈折の光軸と第1偏光板160の軸を同軸にすることができるので、複屈折の影響を排除し、ガラス繊維の重なり部分で、それ以外の部分と同じ正常表示が可能になるという利点がある。そのため、安価なガラスクロス入りのプラスチック基板を使用することができ、液晶表示装置の製造コストが安くなる。

【実施例3】

【0064】

本発明の液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に係る第3実施例を、図12~図13の断面図によって説明する。第3実施例では、薄膜デバイス層が形成された第1基板(ガラス基板)の一部を残した状態で薄膜デバイス層を、ガラスクロスを含有する樹脂基板に移載してアクティブ基板を形成した液晶表示装置を作製した。

【0065】

まず、前記第1実施例の前記図3によって説明したのと同様な製造方法によって、薄膜デバイス層を形成する。

【0066】

次に、図12(1)に示すように第1基板301上に薄膜デバイス層321を形成したものをホットプレート322で80~140に加熱しながら、第1接着層323を、例えばホットメルト接着剤を例えば1mm程度の厚さに塗布して形成した。次に、上記第1接着層323上に第2基板324を載せ、第2基板324を第1基板301方向に加圧しながら、室温まで冷却した。上記第2基板324には、例えば厚さが1mmのモリブデン(Mo)基板を用いた。または、第2基板324上にホットメルト接着剤を塗布して、その上に薄膜デバイス層321が形成された第1基板301の薄膜デバイス層321側を

10

20

30

40

50

載せてもよい。

【0067】

次に、図12(2)に示すように、第2基板324を貼り付けた基板をフッ化水素酸325に浸漬して、第1基板301のエッチングを行った。このエッチングでは、第1基板301が例えばおよそ30 μ mの厚さが残るように、エッチング終点は例えばエッチング時間により制御する。一例として、ここで用いたフッ化水素酸325は重量濃度15%~25%のもので、このエッチング時間はエアブローによるバブリングによって弗化水素酸溶液を攪拌しながら室温で約3時間とした。フッ化水素酸325の濃度とエッチング時間は、適宜変更しても問題はない。上記エッチングの代わりに、例えば機械的な研磨、化学的機械研磨等の研磨によって、第1基板301を薄くしても良い。

10

【0068】

上記フッ化水素酸325によるエッチングの結果、図13(3)に示すように、第1基板301上に薄膜デバイス層321が形成され、さらに薄膜デバイス層321上に第1接着層323を介して第2基板324が形成されたものが得られる。

【0069】

その後、図13(4)に示すように、上記第1基板301の上記薄膜デバイス層321が形成されている面とは反対側の面に第2接着層326を形成する。上記第2接着層326は、一例として、回転塗布技術により例えばアクリル系の紫外線硬化接着剤を塗布して形成した。回転塗布技術による膜形成では、膜厚を約10 μ mとした。

【0070】

20

続けて、上記第2接着層326に第3基板(プラスチック基板)327を貼り付けた。第3基板(プラスチック基板)327には繊維布328が含有されており、例えば第3基板327には、ガラスクロス入りプラスチック基板を用いた。上記プラスチック基板は、酸化ケイ素を主成分とするガラスクロスを含んだエポキシ樹脂で構成されている。ガラスクロスは以下のように形成される。例えば、直径1 μ m~20 μ m程度の細いガラス線を数本から数十本束ねて直径10 μ m~300 μ mの一本の糸とする。今回は、直径約100 μ mの糸を使用した。この糸を平織りにして形成される。平織りのため、縦糸と横糸とが直交している。これにより、基板の線膨張係数は、基板面内の縦方向と横方向とで等しくなる。今回使用した基板の線膨張係数は13ppm/Kである。無機薄膜層との熱膨張率差を考えると30ppm以下、望ましくは15ppm以下がよい。基板の厚さは、10 μ m~500 μ mが望ましく、今回は基板の厚さは200 μ mである。その後、紫外線を照射して第2接着層326を硬化させた。

30

【0071】

次に、上記基板をアルコール(図示せず)中に浸漬し、ホットメルト接着剤からなる第1接着層322〔前記図12(1)参照〕を溶かして第2基板323〔前記図12(1)参照〕を外し、図13(5)に示すように、繊維布328を含有する第3基板327上に第2接着層326、第1基板301を介して薄膜デバイス層321が載った薄膜デバイス(アクティブ基板)300を得た。

【0072】

その後の工程は、前記第1実施例と同様である。

40

【0073】

すなわち、図示はしないが、前記図8によって説明したのと同様にして、上記対向基板130とアクティブ基板300とに配向膜(例えばポリイミド膜)を塗布し、ラビング処理を行う配向処理を行った。ラビング方向は、アクティブ基板300に含有されているガラス繊維方向にラビングを行い、対向基板130とアクティブ基板300で互いに直交するように行った。

【0074】

次に、アクティブ基板300にはシール剤(図示せず)を塗布し、対向基板130には多数のスペーサーを散布した。

【0075】

50

そして、アクティブ基板 300 と対向基板 130 とを張り合わせた後、例えば 1 kg/cm^2 で加圧しながら紫外線を照射してシール剤を硬化させた。次に、レーザー加工によりパネルの大きさに切断した後、注入口から液晶 150 を注入して、注入口をモールド樹脂で覆い、モールド樹脂を硬化させ、液晶表示パネルを作製した。今回は液晶には TN 液晶を用いた。

【0076】

上記第 3 実施例では、前記第 1 実施例と同様に、一对の基板の少なくとも一方の基板、としてアクティブ基板 300 に繊維布 328 を含有している樹脂製の第 3 基板 327 を用い、アクティブ基板 300 および対向基板 130 のそれぞれの外側に第 1、第 2 偏光板 160、170 を備え、繊維の軸と偏光板の光軸とが同軸であるため、複屈折の光軸と第 1 偏光板 160 の軸を同軸にすることができるので、複屈折の影響を排除し、ガラス繊維の重なり部分で、それ以外の部分と同じ正常表示が可能になるという利点がある。そのため、安価なガラスクロス入りのプラスチック基板を使用することができ、液晶表示装置の製造コストが安くなる。

【実施例 4】

【0077】

本発明の液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に係る第 4 実施例を以下に説明する。第 4 実施例では、前記第 1 実施例と同様な製造方法で、第 1 基板上に薄膜デバイス層を設けた薄膜デバイスを形成する。本第 4 実施例では、この第 1 基板に形成した薄膜デバイスをアクティブ基板として用いる。したがって、アクティブ基板は、ガラス基板に薄膜デバイス層を形成したものとなる。一方、対向基板には、前記第 1 実施例の図 7 によって説明したものをを用いる。

【0078】

上記アクティブ基板と対向基板とをスペーサーを介して貼り合わせ、アクティブ基板と対向基板との間の空間に液晶を封止する工程以降は、前記第 1 実施例と同様である。

【0079】

上記第 4 実施例でも前記第 1 実施例と同様な作用効果が得られる。

【産業上の利用可能性】

【0080】

本発明の液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法は、プラスチック基板を用いた液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に適用するのに好適である。

【図面の簡単な説明】

【0081】

【図 1】液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に係る実施の形態を示した概略構成断面図である。

【図 2】本発明の液晶表示装置に係る光透過の概略を示した説明図である。

【図 3】本発明の液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に係る第 1 実施例を示した断面図である。

【図 4】本発明の液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に係る第 1 実施例を示した断面図である。

【図 5】本発明の液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に係る第 1 実施例を示した断面図である。

【図 6】本発明の液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に係る第 1 実施例を示した断面図である。

【図 7】本発明の液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に係る第 1 実施例を示した断面図である。

【図 8】本発明の第 1 実施例に係る液晶表示装置の光透過の概略を示した説明図である。

【図 9】本発明の液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に係る第 2 実施例を示した断面図である。

【図 10】本発明の液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に係る第 2 実施例を示し

10

20

30

40

50

た断面図である。

【図 1 1】本発明の液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に係る第 2 実施例を示した断面図である。

【図 1 2】本発明の液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に係る第 3 実施例を示した断面図である。

【図 1 3】本発明の液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法に係る第 3 実施例を示した断面図である。

【図 1 4】従来の透過型の液晶表示装置に使用されるプラスチック基板の説明図である。

【図 1 5】プラスチック基板中の繊維布の説明図である。

【図 1 6】従来の液晶表示装置の光透過の概略を示した説明図である。

【図 1 7】従来の液晶表示装置の光透過の概略を示した説明図である。

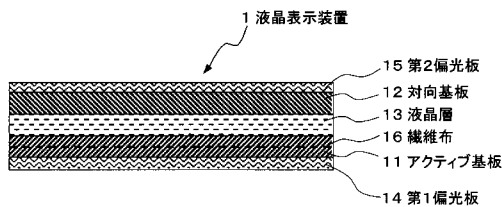
【符号の説明】

【 0 0 8 2 】

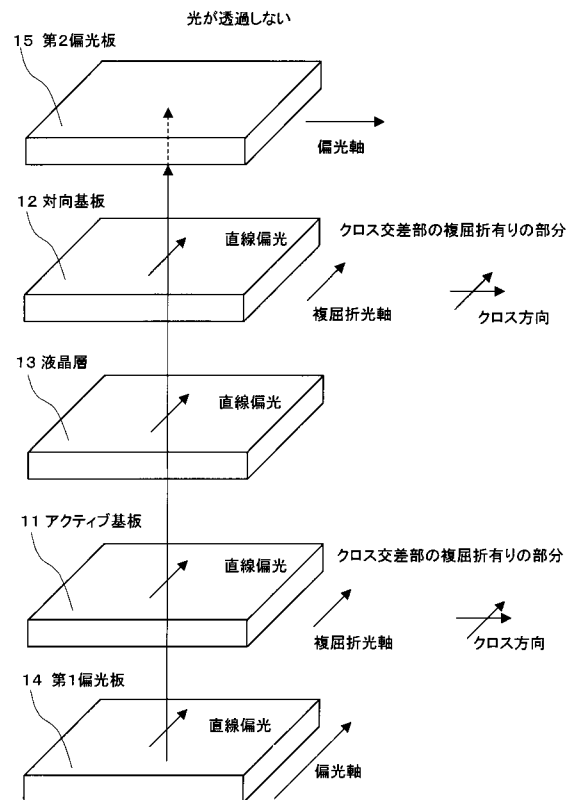
1 ... 液晶表示装置、 1 1 ... アクティブ基板、 1 2 ... 対向基板、 1 3 ... 液晶層、 1 4 ... 第 1 偏光板、 1 5 ... 第 2 偏光板、 1 6 ... 繊維布

10

【図 1】

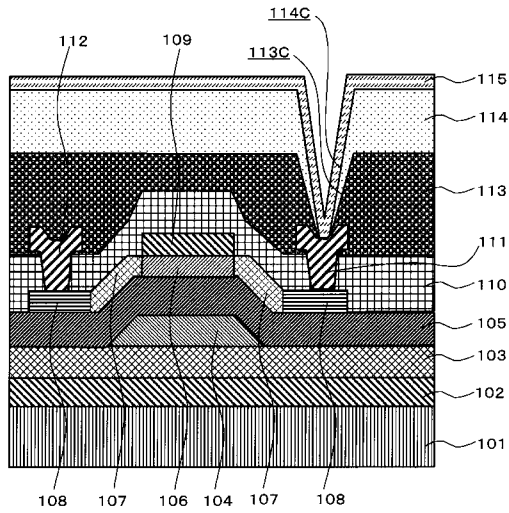


【図 2】

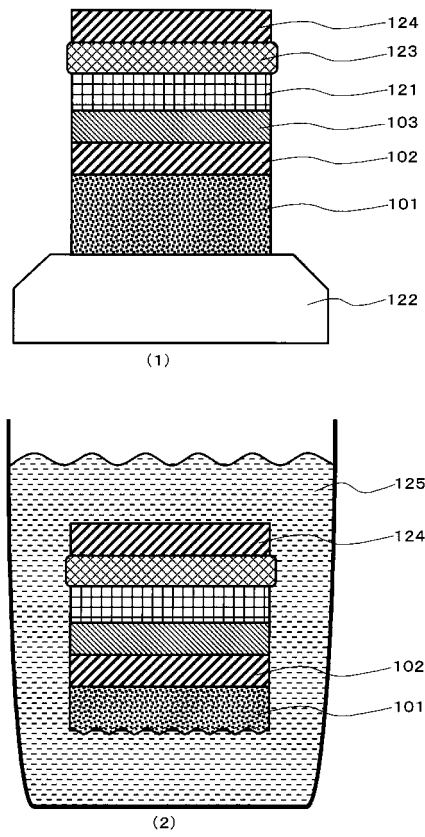


・第1偏光板14の偏光軸⊥第2偏光板15の偏光軸
・複屈折光軸が第1偏光板14の偏光軸と同軸

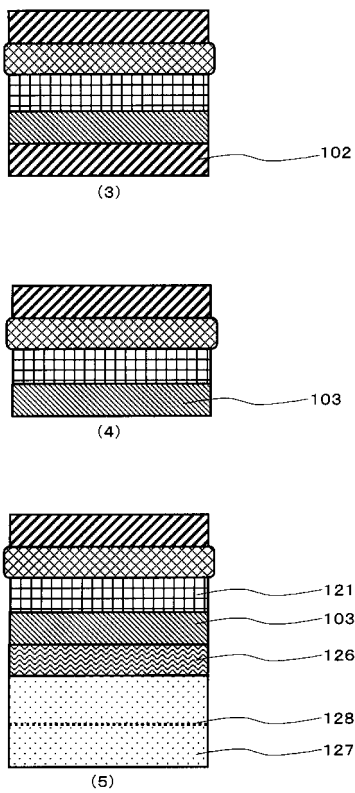
【図 3】



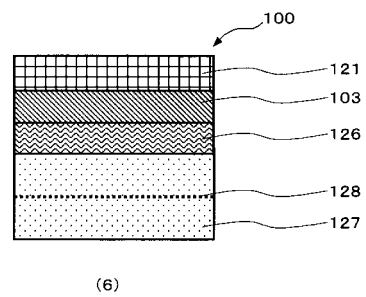
【図 4】



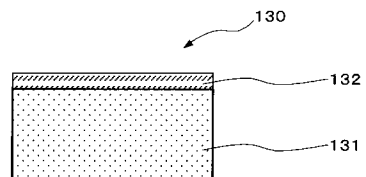
【図 5】



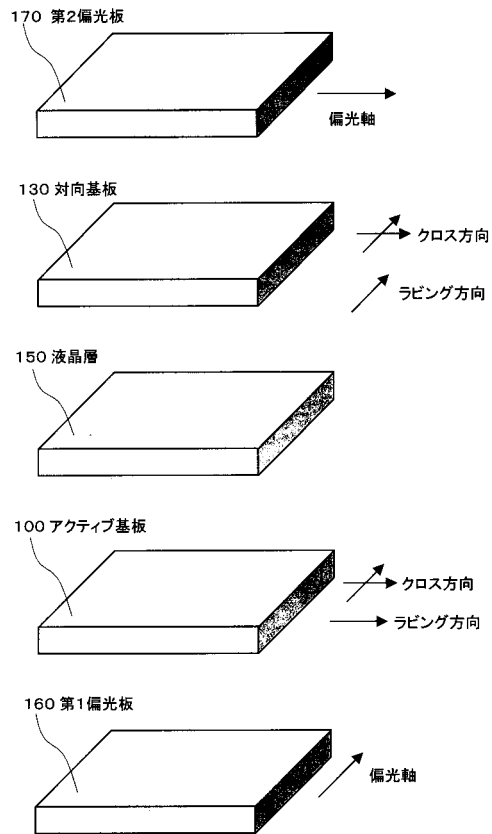
【図 6】



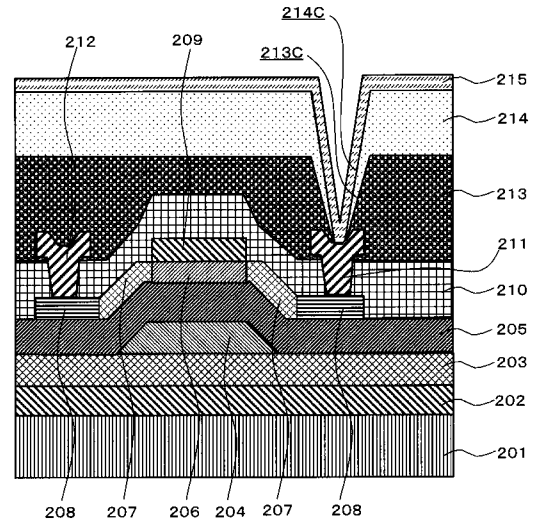
【図 7】



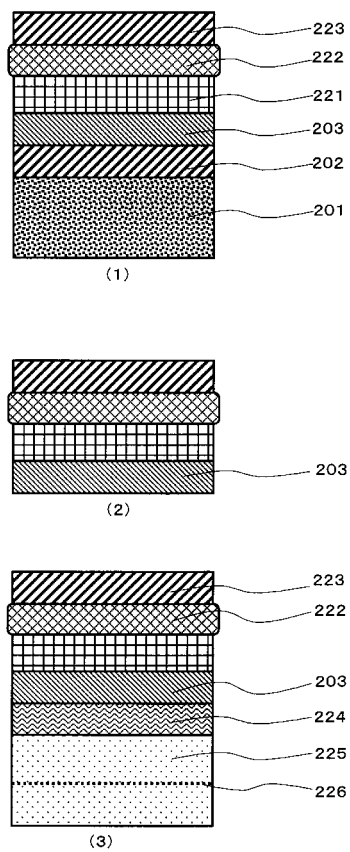
【図 8】



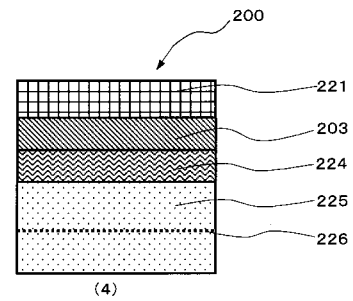
【図 9】



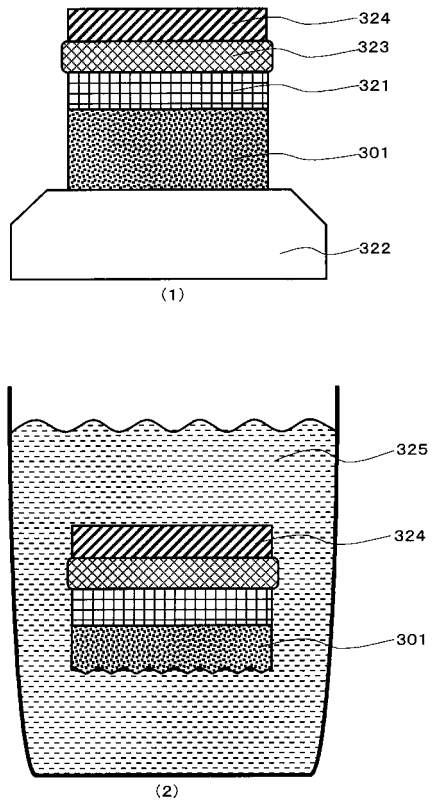
【図 10】



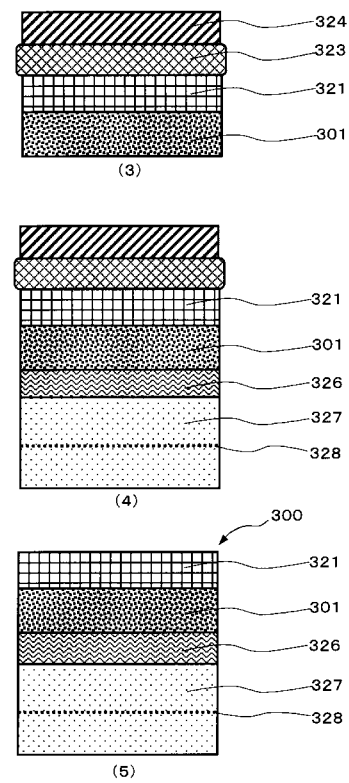
【図 11】



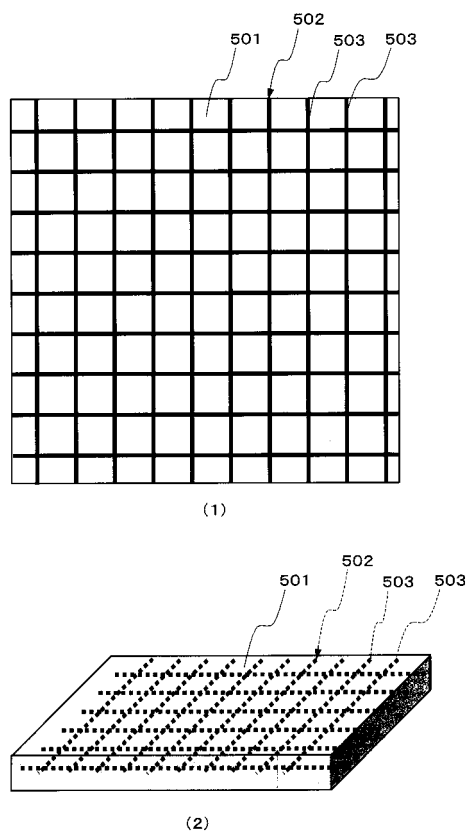
【図 1 2】



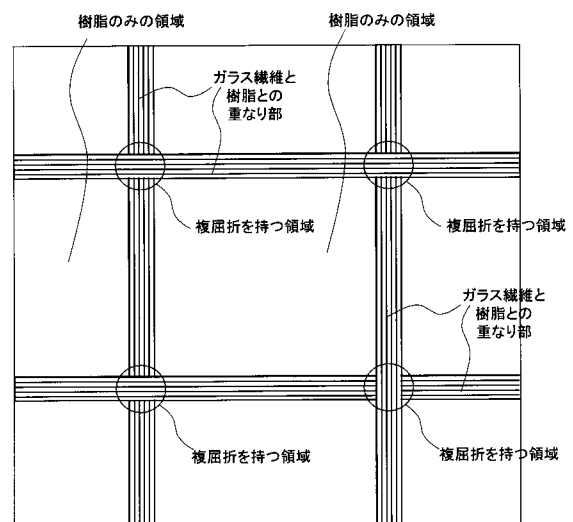
【図 1 3】



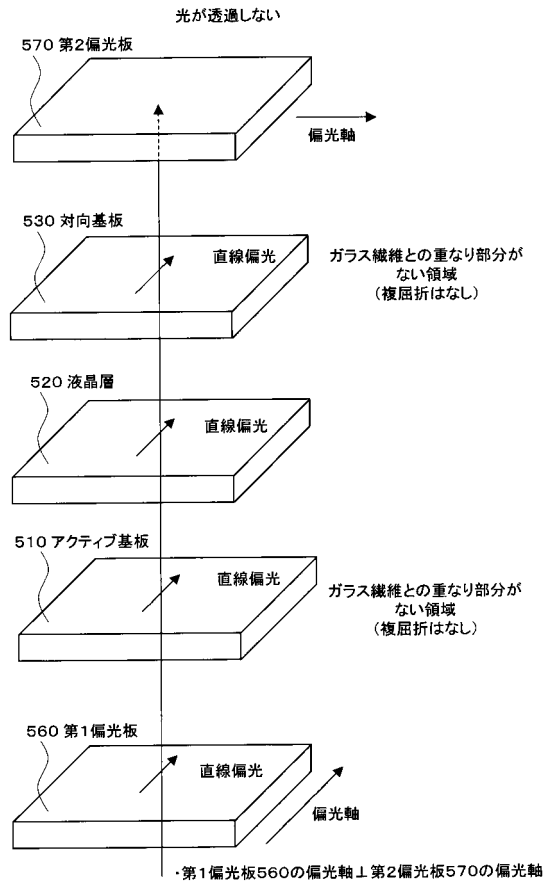
【図 1 4】



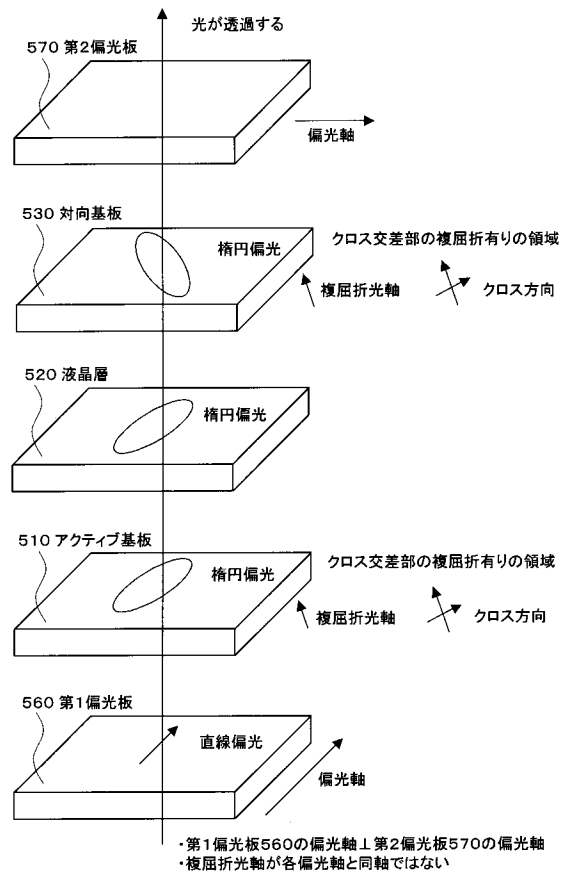
【図 1 5】



【図 16】



【図 17】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開 2 0 0 1 - 1 3 3 7 6 1 (J P , A)
特開平 0 6 - 2 3 5 8 1 7 (J P , A)
特開平 0 2 - 0 0 5 0 2 1 (J P , A)
特開 2 0 0 3 - 2 3 2 9 2 9 (J P , A)
特開 2 0 0 1 - 0 0 7 3 4 0 (J P , A)
特開 2 0 0 3 - 2 0 2 8 1 6 (J P , A)
特開 2 0 0 4 - 2 8 0 0 7 1 (J P , A)

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)

G 0 2 F	1 / 1 3 3 3
G 0 2 F	1 / 1 3 3 5

专利名称(译)	液晶显示装置和液晶显示装置的制造方法		
公开(公告)号	JP4063225B2	公开(公告)日	2008-03-19
申请号	JP2004012612	申请日	2004-01-21
[标]申请(专利权)人(译)	索尼公司		
申请(专利权)人(译)	索尼公司		
当前申请(专利权)人(译)	索尼公司		
[标]发明人	木下智豊 浅野明彦		
发明人	木下 智豊 浅野 明彦		
IPC分类号	G02F1/1333 G02F1/1335		
CPC分类号	G02F1/133305 G02F2001/133531		
FI分类号	G02F1/1333.500 G02F1/1335.510		
F-TERM分类号	2H090/JA16 2H090/JB02 2H090/JB03 2H090/JB07 2H090/JB10 2H090/LA04 2H090/LA09 2H090/MB01 2H091/FA08 2H091/FB02 2H091/FD08 2H091/FD15 2H091/GA01 2H091/GA13 2H091/HA07 2H091/LA12 2H190/JA16 2H190/JB02 2H190/JB03 2H190/JB07 2H190/JB10 2H190/LA04 2H190/LA09 2H191/FA22X 2H191/FA22Y 2H191/FA22Z 2H191/FB02 2H191/FD09 2H191/FD35 2H191/GA01 2H191/GA19 2H191/HA06 2H191/LA13 2H291/FA22X 2H291/FA22Y 2H291/FA22Z 2H291/FB02 2H291/FD09 2H291/FD35 2H291/GA01 2H291/GA19 2H291/HA06 2H291/LA13		
代理人(译)	船桥 国则		
其他公开文献	JP2005208185A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：通过使光纤的轴和偏振片的光轴彼此同轴来消除光纤重叠的部分与含有纤维布的塑料基板的另一部分之间的亮度差异，使其可以执行正常显示。ŽSOLUTION：在液晶显示装置1中，用于驱动液晶的电极（未示出）形成在彼此相对的一对基板11和相对基板12中的至少一个上以及液晶（液晶层13）密封在通过设置在基板之间的间隔物（未示出）在基板之间保持间隙而形成的空间中，例如，作为一对基板中的至少一个基板的有源基板11是包含纤维布的树脂基板如图16所示，第一和第二偏振板14和15设置在至少一个外侧，例如，一对基板的两侧，以及纤维布16的纤维的轴和第一偏振板的光轴上。图14所示的实施例彼此同轴。Ž

